【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2000-49094(P2000-49094A)
【公開日】平成12年2月18日(2000.2.18)
【出願番号】特願平10-210869
【国際特許分類第７版】
　Ｈ０１Ｌ　21/205
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　21/205

【手続補正書】
【提出日】平成17年7月22日(2005.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
四塩化炭素を炭素源に用いたｐ型ＧａＡｓの膜厚と炭素源供給量との関係を図２に○印で示した。四塩化炭素を炭素源に用いた場合、炭素源の供給量を上げていくと、成長膜厚は著しい減少を示し、p型ＧａＡｓの成長と同時にエッチングが生じていることが明らかである。４．３×１０^{19}／ｃｍ^{3}のホール濃度を有するｐ型ＧａＡｓにおいて、同条件で成長したノンドープのＧａＡｓの成長膜厚の６０％程度であった。この膜厚は、炭素源に一臭化三塩化炭素を用いて同成長条件のもとで同程度のキャリア濃度を得る場合の７３％である。四塩化炭素に比較してもエッチング量を抑制することができる。